

拒絶理由通知書  
(Office Action)

↑  
Date of Dispatch  
Y(2008)/M(Apr)/D(8)

特許出願の番号	特願2007-207275
起案日	平成20年 4月 3日
特許庁審査官	橋本 直明 9707 2G00
特許出願人代理人	松田 正道 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項、第29条の2、第37条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

理 由

[理由1]

この出願は、下記の点で特許法第37条に規定する要件を満たしていない。

記

請求項1に係る発明を特定発明として、その他の請求項に係る発明との関係を検討する。

第一に、請求項1に係る発明は、下記引用文献1-3に開示されているように、従来技術であるから、新規なものではない。

すると、仮に、請求項1に係る発明が何らかの技術課題を解決するものだとしたとしても、当該課題は本願出願前に解決済みであり、未解決の「課題」ではないから、特許法第37条第1号に規定する課題には該当しない。

よって、請求項1に係る発明とその他の請求項に係る発明の間には、出願時まで未解決であって且つ共通する発明の解決しようとする課題が存在しないので、特許法第37条第1号に規定する関係を有していない。

第二に、請求項1に係る発明は新規なものではないので、請求項1に係る発明とその他の請求項に係る発明の間には、新規で且つ共通する発明の主要部が存在しない。

よって、請求項1に係る発明とその他の請求項に係る発明の間には、特許法第37条第2号に規定する関係を有していない。

第三に、請求項1に係る発明とその他の請求項に係る発明の間には、特許法第

37条第3号、第4号、第5号に規定する何れの関係も有していない。

この出願は特許法第37条の規定に違反しているので、請求項1以外の請求項に係る発明については特許法第37条以外の要件についての審査を行っていない。

(なお、審査対象としなかったクレームの中にも、下記理由2-3に該当するクレームが存在する可能性があります。補正により単一性が解消されて、新たに審査対象に含まれることになったクレームが下記理由2-3に該当する場合、最後の拒絶理由が通知されることなく、そのまま拒絶査定となる可能性があります。そのため、補正の際には、補正後の全てのクレームについて、下記理由2-3、特に理由3が解消されているかどうかを検討することをお勧めします。)

[理由2]

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記 of 刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記 of 刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

【請求項1について; 引用文献1】

(備考)

引用文献1のFIG. 3及び対応する説明に記載された発明である。

引用文献1には、画素回路をTFTアレイで形成する点も記載されており、その場合、トランジスタ32のゲートに寄生容量が付随することは原理的に避けられず、必ず発生した状態となる。

そして、トランジスタ32のゲートとトランジスタ30のゲートとが寄生容量で接続されれば、必然的にトランジスタ37のゲートとトランジスタ30のゲートとは当該寄生容量で接続されることになるから、当該寄生容量は本願発明における「第2のコンデンサ」に相当する。

なお、寄生容量が発生することは、本願明細書の【0757】等にも開示されている。図1の寄生容量1381と、図42(a)のコンデンサ19bとは、電

気回路の機能上は等価なものであり、TFTアレイの構造上、その素子構造も大きく異なるものではない。

【請求項1について；引用文献2】

(備考)

引用文献2の実施例1に記載された発明である。

TFTで構成されるスイッチング素子M2のゲートソース間の寄生容量が「第1のコンデンサ」、スイッチング素子M3のゲートドレイン間の寄生容量が、「第2のコンデンサ」に相当する。

【請求項1について；引用文献3】

(備考)

引用文献3のFIG. 6及び対応する説明に記載された発明である。

トランジスタP4(240)のゲートソース間の寄生容量が「第2のコンデンサ」に相当する。

【理由3】

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に特許掲載公報の発行又は出願公開がされた下記の特許出願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同じではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

【請求項1について；先願4】

(備考)

先願4明細書に記載された発明と同一又は実質同一である。

例えば、図244及び対応する説明等の記載を参照されたい。

【請求項1について；先願5】

(備考)

先願5明細書に記載された発明と同一又は実質同一である。

例えば、図210、233及び対応する説明等の記載を参照されたい。

【請求項1について；先願6】

(備考)

先願6明細書に記載された発明と同一又は実質同一である。

例えば、図228, 233, 321及び対応する説明等の記載を参照されたい

。

引用文献等一覧 (List of cited references)

1. 国際公開第99/65011号
2. 特開2001-056667号公報
3. 国際公開第98/48403号
4. 特願2001-349887号 (特開2003-150082号)
5. 特願2001-349888号 (特開2003-150104号)
6. 特願2002-011368号 (特開2003-216100号)

この拒絶理由通知の内容に問い合わせがある場合、または、この案件について面接を希望する場合は、特許審査第一部ナノ物理の橋本までご連絡下さい。

TEL 03-3581-1101 (内線3225)、FAX 03-3592-8858

-----  
先行技術文献調査結果の記録

- ・ 調査した分野      I P C   G 0 9 G 3 / 3 0
- ・ 先行技術文献      国際公開第01/06484号  
                         特開平10-319908号公報  
                         国際公開第01/75852号  
                         特開2002-072250号公報 (図33等)  
                         特開2002-072989号公報 (図31等)

・ 出願人への要請

先願4-6は、本願と出願人又は発明者が共通する公知文献です。このような文献は、出願人による適切な請求項の作成に役立つとともに、迅速かつ的確な審査にも資するものと考えられます。出願・審査請求の際には、このような文献を出願人が知っている先行技術文献として明細書中に開示するとともに、特許を受けようとする発明が、このような文献に基づき特許性を有するものであるか否かについて適切な評価を行っていただくようお願いします。

この先行技術文献調査結果の記録は拒絶理由を構成するものではありません。

## Notice of reasons for refusal

Japanese Patent Application No.2007-207275

Sending date April 8, 2008

### Reasons

#### [Reason 1]

This application does not comply with the requirements of Patent Law Section 37 on the points mentioned below.

### Notes

The invention described in claim 1 is recognized as a specified invention and its relationship with the inventions described in the other claims is discussed below.

Firstly, the invention described in claim 1 is a prior art as disclosed in cited documents 1 to 3 listed below and therefore is not novel.

Accordingly, even if the invention described in claim 1 solves any technical problem, the problem concerned has already been solved prior to the filing of the subject application and is not an unsolved "problem". Therefore, the problem concerned does not fall under a "problem" prescribed by Patent Law Section 37 (i).

Thus, between the invention described in claim 1 and the inventions described in the other claims, there exists no problem to be solved by the invention which had not been solved until the filing and are common to both of them. Therefore, the invention described in claim 1 and the inventions described in the other claims do not have the relationship prescribed by Patent Law Section 37 (i).

Secondly, as the invention described in claim 1 is not novel, there exists, between the invention described in claim 1 and the inventions described in the other claims, no substantial part of the invention which is novel and common to both of them.

Thus, the invention described in claim 1 and the inventions described in the other claims do not have the relationship prescribed by Patent Law Section 37 (ii).

Thirdly, the invention described in claim 1 and the inventions described in the other claims do not have any of the relationships prescribed by Patent Law Section 37 (iii), (iv) and (v).

Since the subject application is in violation of the provisions of Patent Law Section 37, the inventions described in the claims other than claim 1 are not examined as to the requirements concerned other than those of Patent Law Section 37.

(Among the claims that have not been examined, there

can be claims to which the reasons 2 and 3 mentioned below are applicable. When the unity is dissolved by amendment and the reasons 2 and 3 mentioned below are applicable to claims that are newly included in the claims to be examined, decision of refusal may be issued without final notification of reasons for refusal. Therefore, it is recommended that, on an occasion of amendment, whether or not the reasons 2 and 3, especially the reason 3, mentioned below are dissolved is investigated for all the amended claims.)

[Reason 2]

1. The invention described in the claim mentioned below of the subject application should not be granted a patent under Patent Law Section 29 (1)(iii) since it is an invention described in the publications mentioned below which were distributed or an invention made available to the public through electric telecommunication lines in Japan or foreign countries prior to the filing of the subject application.

2. The invention described in the claim mentioned below of the subject application should not be granted a patent under Patent Law Section 29(2) since it could have easily been made prior to the filing of the subject application by a person who has common knowledge in the technical field

to which the invention pertains, on the basis of the invention described in the publications mentioned below which were distributed or an invention made available to the public through electric telecommunication lines in Japan or foreign countries prior to the filing of the subject application.

Notes (With regard to the cited documents etc., see the list of cited documents etc. below.)

[With regard to claim 1; Cited document 1]

(Remarks)

The invention described in claim 1 is identical to the invention described in FIG. 3 and its corresponding description in the cited document 1.

The cited document 1 describes that a pixel circuit is formed of a TFT array. In this case, it cannot be avoided theoretically that parasitic capacitance is generated at the gate of the transistor 32, and thus the parasitic capacitance is inevitably generated.

When the gate of the transistor 32 and the gate of the transistor 30 are connected by parasitic capacitance, the gate of the transistor 37 and the gate of the transistor 30 are necessarily connected by the parasitic capacitance concerned. The parasitic capacitance concerned thus corresponds to the "second capacitor" in the claimed



invention.

Note that the generation of parasitic capacitance is disclosed in paragraph [0757] and the like of the specification of the subject application. The parasitic capacitance 1381 in FIG. 1 and the capacitor 19b in FIG. 42(a) are equivalent in terms of the function of an electric circuit, and their device structures do not greatly differ from each other with regard to the structure of a TFT array.

[With regard to claim 1; Cited document 2]

(Remarks)

The invention described in claim 1 is identical to the invention described in the example 1 of the cited document 2.

The parasitic capacitance between the gate and the source of the switching element M2 made of a TFT corresponds to the "first capacitor", and the parasitic capacitance between the gate and the drain of the switching element M3 corresponds to the "second capacitor".

[With regard to claim 1; Cited document 3]

(Remarks)

The invention described in claim 1 is identical to the invention described in FIG. 6 and its corresponding description in the cited document 3.

The parasitic capacitance between the gate and the source of the transistor P4 (240) corresponds to the "second capacitor".

[Reason 3]

The invention described in the claim mentioned below of the subject application should not be granted a patent under Patent Law Section 29bis since it is identical to an invention described in the specification, claims or drawings originally attached to the request of the application for patent mentioned below, which had been filed prior to the filing date of the subject application and for which an official gazette was issued or which was laid open after the filing of the subject application, the inventor of the subject application is not identical to the inventor who has made the above invention according to the patent application prior to the filing of the subject application, and the applicant of the subject application is not identical to the applicant of the above patent application at the time of filing of the subject application.

Notes (With regard to the cited documents etc., see the list of cited documents etc. below.)

[With regard to claim 1; Prior application 4]

(Remarks)

The invention described in claim 1 is identical or substantially identical to the invention described in the specification of the prior application 4.

For example, refer to FIG. 244 and its corresponding descriptions and the like.

[With regard to claim 1; Prior application 5]

(Remarks)

The invention described in claim 1 is identical or substantially identical to the invention described in the specification of the prior application 5.

For example, refer to FIGS. 210 and 233 and their corresponding descriptions.

[With regard to claim 1; Prior application 6]

(Remarks)

The invention described in claim 1 is identical or substantially identical to the invention described in the specification of the prior application 6.

For example, refer to FIGS. 228, 233 and 321 and their corresponding descriptions.

#### list of cited references

1. International Publication WO99/65011

2. Japanese Patent Laid-Open No.2001-056667
3. International Publication WO98/48403 *PC* 9-10-07
4. Japanese Patent Application No.2001-349887 }  
(Japanese Patent Laid-Open No.2003-150082)
5. Japanese Patent Application No.2001-349888 }  
(Japanese Patent Laid-Open No.2003-150104) *PC* 10-25-04
6. Japanese Patent Application No.2002-011368 }  
(Japanese Patent Laid-Open No.2003-216100) *PC* 12-12-07

*pc = previously cited*